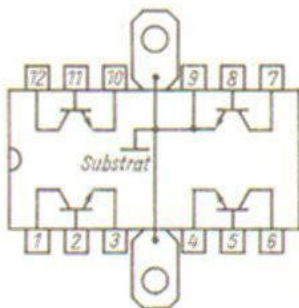
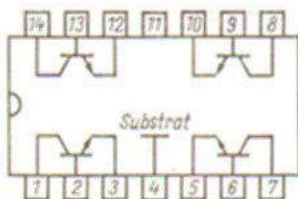


B 315 D, E, K · B 325 D, E, K · B 360 D, E, K ·
B 380 D, E, K

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transistoren ohne und mit Kühlkörper.

Bauform 4 (D-Typen)
20 (E-Typen)
21 (K-Typen)



Innere Schaltung und Anschlußbelegung

B 315 D, B 325 D, B 360 D,
B 380 D

- 1 Kollektor T 1
- 2 Basis T 1
- 3 Emitter T 1
- 4 Substrat
- 5 Emitter T 2
- 6 Basis T 2
- 7 Kollektor T 2
- 8 Kollektor T 3
- 9 Basis T 3
- 10 Emitter T 3
- 11 frei
- 12 Emitter T 4
- 13 Basis T 4
- 14 Kollektor T 4

B 315 E, K; B 325 E, K;
B 360 E, K; B 380 E, K

- 1 Kollektor T 1
- 2 Basis T 1
- 3 Emitter T 1
- 4 Emitter T 2
- 5 Basis T 2
- 6 Kollektor T 2
- 7 Kollektor T 3
- 8 Basis T 3
- 9 Emitter T 3 (Substrat)
- 10 Emitter T 4
- 11 Basis T 4
- 12 Kollektor T 4

Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

		B 315	B 325	B 360	B 380
		max.	max.	max.	max.
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}	15	25	60	80 V
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}	20	30	90	100 V
Emitter-Basis-Spannung ^f	U_{EB0}			5	V
Kollektorstrom	I_C		0,5		A
Impulsspitzenstrom	I_C		1,0		A
Gesamtverlustleistung	P_{tot} (3..D)		1,3		W
	P_{tot} (3..E)		1,8		W
	P_{tot} (3..K)		4,0		W
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a		-25 ... +85		°C
Sperrschichttemperatur	ϑ_{jmax}		150		°C
Gesamtwärmewiderstand	R_{thja} (3..D)		85		K/W
	R_{thj} (3..E)		65		K/W
	R_{thja} (3..K)		30		K/W

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$):

		min.	max.
Gleichstromverstärkung ^h			
$U_{CE} = 3\text{ V}, I_C = 50\text{ mA}$	$h_{21E} (T1)$		
Gruppe b		28	71
Gruppe c		56	140
Gruppe d		112	280
Gruppe e		224	560
Kollektor-Basis-Reststrom	I_{CBO}		100 nA
$U_{CB} = 20\text{ V}$ B 315 D, E, K			
$U_{CB} = 30\text{ V}$ B 325 D, E, K			
$U_{CB} = 80\text{ V}$ B 360 D, E, K			
B 380 D, E, K			
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung			0,5 V
$I_C = 50\text{ mA}$ $I_B = 10\text{ mA}$	U_{CEsat}		
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung		B 315 B 352 B 360 B 380	
$I_C = 1\text{ mA}$	$U_{(BR)CEO}$	15 20 60 80	V

	B 315	B 325	B 360	B 380	
	min.	min.	min.	min. max.	
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung $I_C = 100 \mu A$	$U_{(BR)CBO}$	20	30	90	100 V
Gleichstromverstärkungsgleichheit der Transistoren untereinander ¹⁾					
$U_{CE} = 3 V, I_C = 50 mA$			0,8	1,25	

Dynamische Kennwerte ($\theta_a = 25^\circ C - 5 K$)

		min.	max.	
Übergangsfrequenz				
$U_{CE} = 10 V, I_C = 10 mA$	f_T	60		MHz
$f = 15 MHz$				

- ¹⁾ B 315 D, E, K – Vorzugsgruppe d
 B 325 D, E, K – Vorzugsgruppe d
 B 360 D, E, K – Vorzugsgruppe c
 B 380 D, E, K nur Gruppe b-d; Vorzugsgruppe c
²⁾ nicht für B 380 D, E, K